

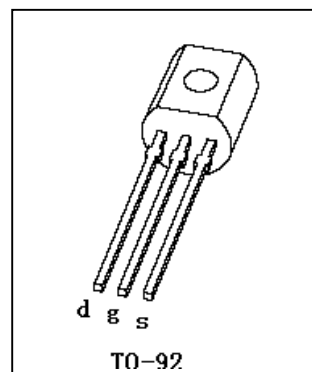
## N 沟纵向 MOSFET

### 描述:

N 沟增强型 VDMOS, 高速开关, 无二次击穿

### 产品应用:

- 电话机电路
- 继电器电路
- 驱动电路等



### 工作条件 (T=25℃)

| 符号             | 参数                                   | 极限值         | 单位 |
|----------------|--------------------------------------|-------------|----|
| $V_{DS}$       | 漏源电压                                 | 200         | V  |
| $V_{GS}$       | 栅源电压                                 | $\pm 20$    | V  |
| $I_D$          | 漏电流                                  | 300         | mA |
| $P_D$          | Power Dissipation for Dual Operation | 1           | W  |
| $T_j, T_{SDG}$ | 结温度和存储温度                             | -55 to +150 | ℃  |

### 热特性

|               |                                         |     |     |
|---------------|-----------------------------------------|-----|-----|
| $R_{th\ j-a}$ | Thermal Resistance, Junction to Ambient | 125 | K/W |
|---------------|-----------------------------------------|-----|-----|

### 电学特性 $T_A=25^\circ\text{C}$

| 符号           | 参数         | 测试条件                            | 最小  | 典型 | 最大        | 单位       |
|--------------|------------|---------------------------------|-----|----|-----------|----------|
| $BV_{DSS}$   | 源漏击穿电压     | $V_{GS} = 0V, I_D = 10\mu A$    | 200 |    |           | V        |
| $I_{DSS}$    | 零栅压时的漏极电流  | $V_{DS} = 160V, V_{GS} = 0V$    |     |    | 1         | $\mu A$  |
| $I_{GSS}$    | 栅和衬底之间的漏电流 | $V_{GS} = \pm 20V, V_{DS} = 0V$ |     |    | $\pm 100$ | nA       |
| $V_{GS(th)}$ | 阈值电压       | $V_{DS} = V_{GS}, I_D = 1mA$    | 0.4 |    | 1.8       | V        |
| $R_{DS(on)}$ | 导通电阻       | $V_{GS} = 2.8V, I_D = 100mA$    |     |    | 5         | $\Omega$ |

**交流特性**

|      |      |                                       |  |     |  |    |
|------|------|---------------------------------------|--|-----|--|----|
| Ciss | 输入电容 | $V_{DS}=25V, V_{GS}=0V$<br>$f = 1MHz$ |  | 120 |  | pF |
| Coss | 输出电容 |                                       |  | 30  |  | pF |
| Crss | 反馈电容 |                                       |  | 15  |  | pF |

**开关特性**

|           |             |                                                       |  |    |    |    |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------|--|----|----|----|
| $t_{on}$  | Turn-On 时间  | $V_{DD}=50V, I_D=250mA$<br>$V_{GS}=0 \text{ to } 10V$ |  | 6  | 10 | ns |
| $t_{off}$ | Turn-Off 时间 |                                                       |  | 49 | 60 | ns |